

專利再審查理由書

一、依據：

貴局 104 年 3 月 27 日 04305 字第 10420399900 號專利核駁審定書。
申請人爰於法定期間內提出再審查說明，謹請 貴局參酌再審查理由
予以審定。

二、申請再審查理由：

第一獨立項(請求項 1)

針對審查委員於核駁審定書第 3 頁中間"1 段落"將引證 2 第 8 頁倒數第 2 行-第 9 頁第 6 行所述之形成的材料層比對本案磊晶層，申請人認為一般用來形成側壁子的材料層會選自由氧化矽或氮化矽所構成的介電材料，而非磊晶層。加上引證 2 於文中從未提到該材料層是由磊晶所構成，因此直接將引用段落中的材料層比對到本案磊晶層並不恰當。在缺乏磊晶層的情況下，申請人認為引證案無法合理帶出磊晶層之後再以一次微影暨蝕刻劃分閘極結構的順序性。

其次，引證 2 用來形成側壁子的材料層明顯是在對閘極圖案(此時的閘極圖案並非 104)進行第二微影暨蝕刻製程後才覆蓋於閘極圖案 104 上。因此若審查委員將引證 2 用來形成側壁子的材料層比對本案磊晶層，則引證 2 應該是在形成磊晶層(材料層)之前便對閘極圖案(未出現於引證 2 圖示中)進行第二微影暨蝕刻製程形成閘極圖案 104，而非形成磊晶層(材料層)之後才對閘極圖案進行第二微影暨蝕刻製程形成閘極圖案 104。

整體來看，申請人認為引證 1 與引證 2 的結合不論在製程順序上或元件關係上(例如直接引證 2 的側壁子材料比對本案的磊晶層)均與本案有極大差異。

第二獨立項(請求項 11)

針對審查委員於核駁審定書第 4 頁"2 段落"所提到"...引證 2 第 4 圖揭示一開口(114)僅為每一方向上，為該領域技術之通常知識者，可輕易利用引證 2 之回蝕開口之方法用於垂直於開口(114)之方向，當此技術用於閘極四側壁上如此反覆沉積後再蝕刻後再分離閘極，在這過

程中便會在側壁子設於閘及側壁的情況下以蝕刻同時去除部分側壁子極部分閘極..."的論點，申請人認為若依據審查委員的解讀於閘極四側壁上如此反覆沉積後再蝕刻後再分離閘極，則引證案的確會出現如本案"閘極四側壁中之兩對向側壁具有一側壁子而另兩對向側壁無該側壁子"的閘極結構。

但目前的關鍵在於引證 2 於第 3 圖至第 4 圖僅揭露於閘極側壁形成側壁子 112，並無任何形成側壁子 112 後再分離閘極的動作，因此不可能出現如本案"閘極四側壁中之兩對向側壁具有一側壁子而另兩對向側壁無該側壁子"的結構。

由於上述技術特徵均未明確揭露於審查委員所舉之各引證案，本案請求項 1、11 應已符合專利法第 22 條第 2 項之規定。另外請求項 2-10 以及請求項 12-14 為請求項 1、11 之附屬項，若請求項 1、11 具可專利性，則其相對應之附屬項也應具有可專利性。

綜上所陳，貴局擬拒予本案專利之理由應已不存在，依專利法第四十七條第一項前段規定「申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利」，懇請貴局惠予審查，早日准予發明專利為禱，實感德便。

謹呈

經濟部智慧財產局 公鑒